



压控晶体振荡器

Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO)



表面贴装型VCXO KV5032D-C3系列

CMOS/ 3.3V/ 5.0×3.2mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 小型陶瓷封装类型
- 高可靠性的缝焊
- CMOS输出
- 电源电压 Vcc = 3.3V
- 低抖动

■频率容差(Overall)

容差	工作温度范围(°C)	备注
0 ±50	-10 ~ +70	标准规范
S ±30	-10 ~ +70	工作频率敬请咨询。
G ±50	-40 ~ +85	

■型号表示方法

KV5032D 24.576 C 3 □ D 00
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列名称
- ②输出频率
- ③输出形式(CMOS)
- ④电源电压(3.3V)
- ⑤频率容差(参见左表)
- ⑥对称/INH功能/控制输入电阻的组合
- ⑦个别规格(产品目录以00标示)

包装方式(载带包装 1000个/卷盘)

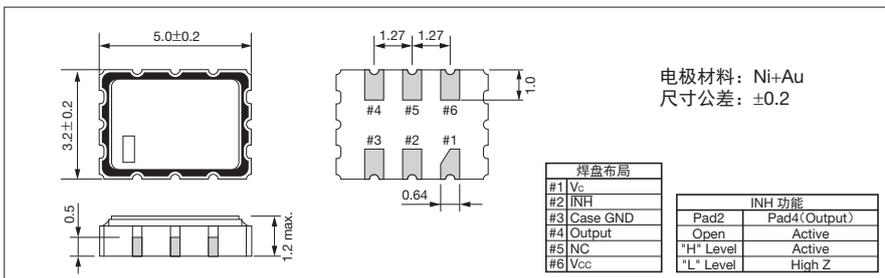
■规格

项 目	记 号	条 件	Min.	Max.	单 位	
输出频率范围*	fo		1.5	170	MHz	
频率容差	f _{tol}	起始偏差、工作温度范围内的温度特性、电源电压变化、负载容量变化、长期变化(1年@25°C)、包括振动和冲击 Temp.: -10 ~ +70°C/ -40 ~ +85°C	-50	+50	×10 ⁻⁶	
绝对频率可变范围(APR)	APR	1.5 ≤ fo ≤ 30MHz 30 < fo ≤ 170MHz	±100 ±50	—	×10 ⁻⁶	
控制电压	Vc		0	+3.3	V	
储存温度范围	T _{stg}		-55	+125	°C	
工作温度范围	T _{use}	标准规范 选项	-10 -40	+70 +85	°C	
最大的额定电压	—	1.5 ≤ fo ≤ 80MHz 80 < fo ≤ 170MHz	-0.5 -0.5	+7 +5	V	
电源电压	Vcc		+2.97	+3.63	V	
电流消耗	Icc	1.5 ≤ fo ≤ 80MHz 80 < fo ≤ 170MHz	—	15 35	mA	
禁用时电流	I _{dis}	1.5 ≤ fo ≤ 80MHz 80 < fo ≤ 170MHz	—	10 50	mA μA	
波形对称	SYM	50ohm @50% Vcc	45	55	%	
上升/下降时间(10% Vcc ~ 90% Vcc)	Tr/ Tf	1.5 ≤ fo ≤ 30MHz 30 < fo ≤ 80MHz 80 < fo ≤ 170MHz	—	8 5 4	ns	
L电平输出电压	VOL		—	10% Vcc	V	
H电平输出电压	VOH		90% Vcc	—	V	
输出负载条件(CMOS)	L_CMOS	CMOS Output	—	15	pF	
输入电压范围	VIN		0	+3.3	V	
L电平输入电压	VIL		—	30% Vcc	V	
H电平输入电压	VIH		70% Vcc	—	V	
控制输入电阻	—	控制输入电阻值代号⑥: D 控制输入电阻值代号⑥: G or N	100 5	—	k ohm Mohm	
禁用时间	t _{dis}		—	100	ns	
启用时间	t _{ena}	1.5 ≤ fo ≤ 80MHz 80 < fo ≤ 170MHz	—	100 2	ns ms	
振荡启动时间	t _{str}	最小动作电压为0sec.	—	10	ms	
Phase Jitter	JPhase	@155.52MHz	—	1.0	ps	
Phase Noise	—	@155.52MHz	BW: 12kHz ~ 20MHz	—	—	dBc/ Hz
			@10Hz offset	—	Typ. -55	
			@100Hz offset	—	Typ. -85	
			@1kHz offset	—	Typ. -115	
			@10kHz offset	—	Typ. -130	
			@100kHz offset	—	Typ. -145	
			@1MHz offset	—	Typ. -150	
@10MHz offset	—	Typ. -155				

所有的电气特性是以最大负载时, 并在工作温度范围内为条件。
 * 输出频率超出该范围的, 敬请咨询。

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

